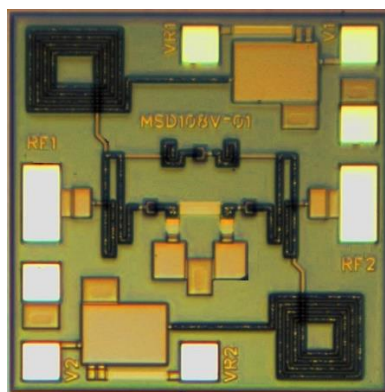


Основные характеристики:

- Полоса рабочих частот:
от 4,0 до 8,0 ГГц
- Начальные потери $L_{НАЧ}$:
 $L_{НАЧ} \leq 1,3$ дБ
- Вносимое ослабление $L_{АТТ}$:
 $L_{АТТ} = 20,0$ дБ
- Входная мощность $P_{-1дБ}$:
 $P_{-1дБ} = 20$ дБм
- Уровень сигналов TTL:
 $U_{УПР} = 0/3,3$ В
- Размеры кристалла:
 $1,0 \times 1,0 \times 0,1$ мм³



Общее описание:

Модуль MSD108V – однобитный 20-децибельный GaAs p-i-n-диодный аттенуатор с вносимыми потерями 1,3 дБ и TTL-управлением

Исполнение:

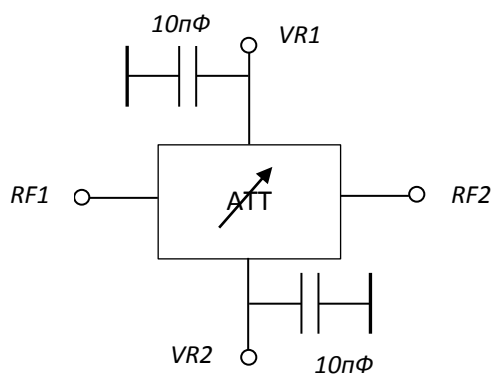
Модуль СВЧ бескорпусной (кристалл)

Основные электрические характеристики (T=25°C)

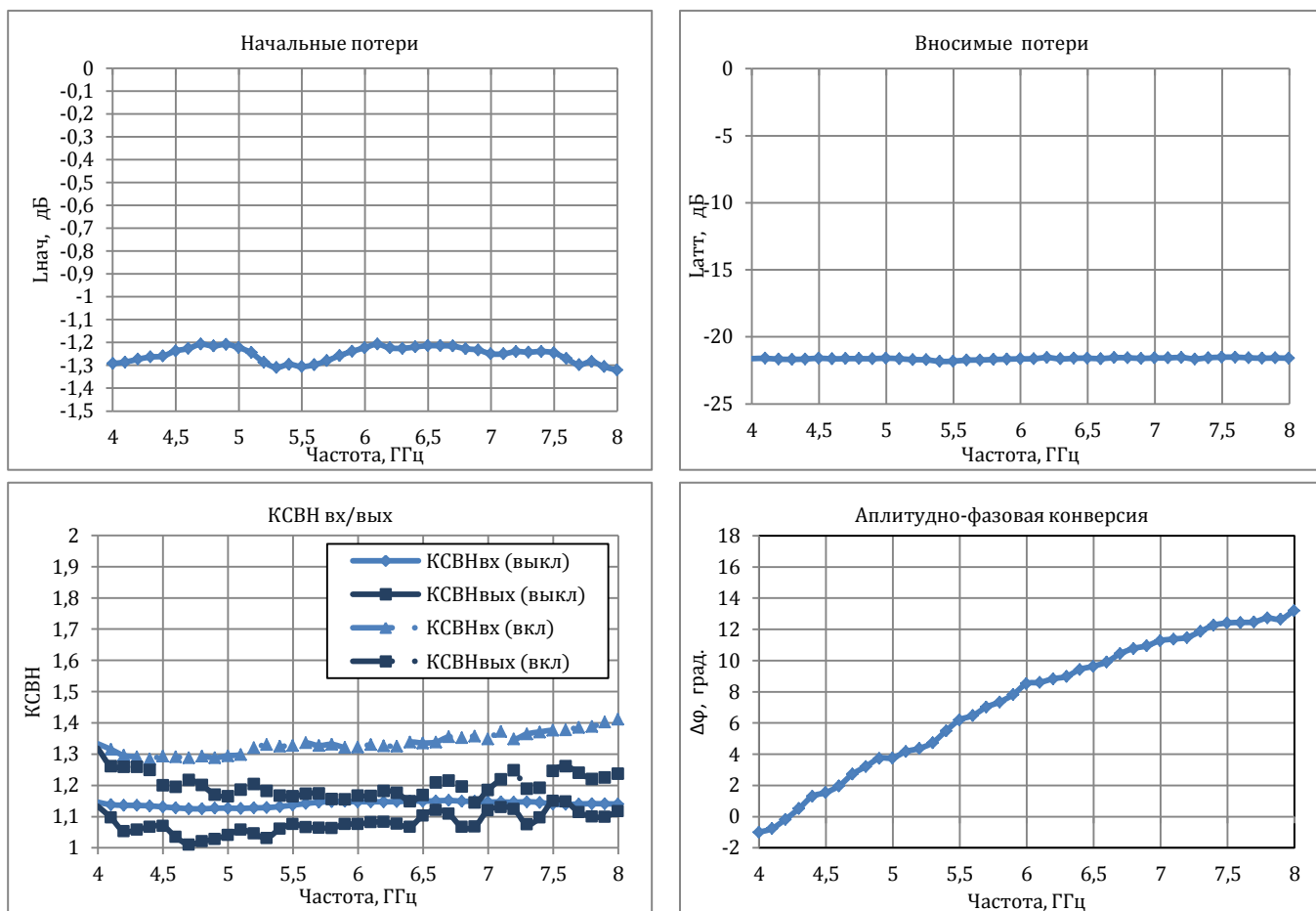
Наименование параметра	Обозначение	Ед. изм.	Значение		Примечание
			Не менее	Не более	
Диапазон рабочих частот	ΔF	ГГц	4	8	
Начальные потери	$L_{НАЧ}$	дБ	–	1,3	
Вносимое ослабление	$L_{АТТ}$	дБ	–	20,0	
Входная мощность $P_{-1дБ}$	P_{-1}	дБм	20	–	
КСВН вход / выход	КСВН	–	–	1,8 / 1,8	
Ошибка вносимого ослабления	$L_{АТТ}$	дБ	–	0,4	
Паразитная амплитудно-фазовая конверсия	$\Delta\Phi$	град	минус 2	13	

Предельно допустимые параметры

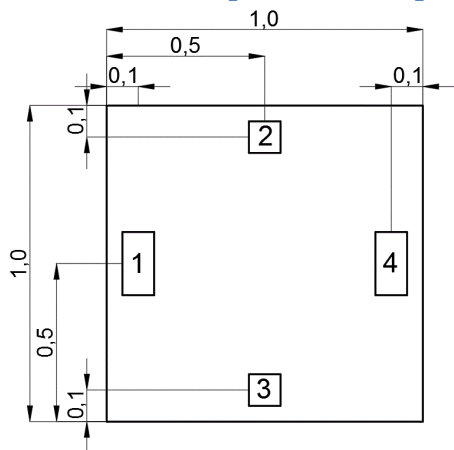
Наименование параметра	Обозначение	Значение
Максимальная входная мощность	$P_{вх.макс}$	+27 дБм
Диапазон рабочих температур	$T_{раб}$	–60...85°C
Температура хранения	$T_{хран}$	–65...150°C



Типовые частотные характеристики



Габаритные и присоединительные размеры



- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Размеры контактных площадок:
 - «RF1», «RF2» – $0,2 \times 0,1 \text{ мм}^2$
 - «VR1», «VR2» – $0,1 \times 0,1 \text{ мм}^2$
- Обратная сторона – земля.
- Покрытие контактных площадок и обратной стороны – золото.

Назначение выводов

Вывод	Наименование	Назначение
1	RF1	Вход/Выход СВЧ сигнала
2	VR1	Управление состоянием
3	VR2	Управление состоянием
4	RF2	Выход/Вход СВЧ сигнала

Управление состоянием

VR1 [В]	VR2	Состояние
0... 0,4	3,0...5,0	$L_{нач}$
3,0...5,0	0... 0,4	$L_{втг}$